

## Сведения и публикации официального оппонента Бублика В.Т.

по диссертационной работе Носика Валерия Леонидовича на тему «Теоретические аспекты взаимодействия рентгеновского излучения с кристаллами с искаженной решеткой» на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.07 – «Физика конденсированного состояния»

ФИО, ученая степень, должность	Бублик Владимир Тимофеевич, доктор физико-математических наук, профессор кафедры Материаловедения полупроводников и ди- электриков
Полное наименование ор- ганизации Краткое наименование ор- ганизации	Национальный исследовательский технологический универси- тет «МИСиС», НИТУ «МИСиС»
Ведомственная принадлеж- ность	Министерство образования и науки Российской Федерации
Почтовый индекс, адрес	119049, Москва, Ленинский проспект, д.4
Веб-сайт	<a href="http://misis.ru/university/">http://misis.ru/university/</a>
Телефон	+7 495 647-60-21
Адрес электронной почты	<a href="mailto:pegovas@misis.ru">pegovas@misis.ru</a>
<b>Публикации по специальности 01.04.07 по физико-математическим наукам</b>	
1. The influence of photoexcitation in situ on a generation of defect structure during ion implan- tation into Si substrates, J. of Physics D: Appl. Phys. 2005. 38(10A) P. A126-A131/ V. T. Bublik, V. N. Mordkovich, K.D.Shcherbachev, D. M. Pazhin.	
2. Влияние облучения реакторными нейтронами и температуры на структуру монокри- сталлов InP, ФТП, 2006, том 40, выпуск 6, С.641-649/ В.М.Бойко, В.Т.Бублик, М.И.Воронова, Н.Г.Коллин, Д.И.Меркурисов, К.Д.Щербачев.	
3. Structure of InP single crystals irradiated with reactor neutrons, Phisica B: Physics of Con- densed Matter. 2006. V. 373. P. 82-89/ V.M. Boyko, V.T. Bubljk, M.I. Voronova, N.G. Kolin, D.I. Mercurisov, K.D. Shcherbachev.	
4. Electrical and structural properties of InSb crystals irradiated with reactor neutrons, Phisica B: Physics of Condensed Matter. 2006. V. 371. P. 272-279/ V.M. Boyko, V.T. Bubljk, M.I. Vo- ronova, N.G. Kolin, D.I. Mercurisov, K.D. Shcherbachev.	
5. Исследование микродефектов в монокристаллах GaP и GaP(Zn), выращенных методом ЧЖГР, Кристаллография. 2008. Т. 53. № 2. С. 284-292/ П.А. Филатов, В.Т. Бублик, Т.И. Маркова, М.И. Воронова, К.Д. Щербачев.	

6. Radiation induced structural transformations in a silicon layer of SOI, Phys.Stat.Sol. (a), 2007, 204 N8, P.2645-2650/ V. T. Bublik, V.N.Mordkovich, D. M. Pazhin, E. Alves, N. P. Barradas, K.D.Shcherbachev.
7. Исследование структурных характеристик ферромагнитного Si, имплантированного Mn, Кристаллография, 2008, Т53, С.843/ Орлов А.Ф., Балагуров П.А., Сарайкин В.В., Бублик В.Т., К.Д. Щербачев.
8. В.М.Бойко, К.Д Щербачев, Изменения структуры монокристаллов InSb после облучения нейтронами и термообработок //ФТП, 2006, том 40, выпуск 6, С.641-649
9. П. А. Филатов, В. К.Д Щербачев, А. В. Марков, М. И. Воронова . Влияние содержания В2О3 и условий роста на структурное совершенство кристаллов GaAs(Si), выращенных методом вертикально направленной кристаллизации// Изв. ВУЗов. Материалы электронной техники.- 2006.- №3. – С78-80
10. В.М. Бойко, К.Д Щербачев, М.И. Воронова, Н.Г. Колин, Д.И. Меркурисов .Изменения структуры монокристаллов InSb после облучения нейтронами и термообработок// Физика и техника полупроводников, 2006, том 40, вып. 6, С. 769-777
11. К.Д Щербачев, Шалимов А. Анализ реальной структуры ионоимплантированных слоев на карте обратного пространства// Материалы электронной техники. 2006. № 2. С. 64-68
12. L.V.Kozhitov, T.T.Kondratenko .Single-Crystal X-Ray Diffraction Analysis of Nonplanar Autoepitaxial Silicon Layers// Inorganic Materials. 2009. V. 45. № 14. P. 1610-1613
13. П.А. Филатов, К.Д Щербачев, А.В. Марков, М.И. Воронова . Изучение микродефектов в монокристаллах GaAs(Si), выращенных методом вертикальной направленной кристаллизации // Кристаллография. 2007. Т. 52. № 2. С. 264-269.
14. K.D. Shcherbachev, V.N.Mordkovich, D. M. Pazhin, E. Alves, N. P. Barradas. Radiation induced structural transformations in a silicon layer of SOI// Phys.Stat.Sol. (a), 2007, 204 N8, P.2645-2650.
15. Shchertachev, K.D., Voronova, M., Bublik, V.T. et al. Influence of the chemical nature of implanted ions on the structure of a silicon layer damaged by Implantation //CRYSTALLOGRAPHY REPORTS.2013. V. 58 .N 7. P. 1030.
16. Bulat L, . P., Drabkin L.A., Karatayev V. et al. Structure and Transport Properties of Bulk Nanothermoelectrics Based on Bi (x) Sb2-r Te-3 Fabricated by SPS Method //JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS.2013. V. 4. N.2 . P. 2110.
17. Borik M.A , Bublik V.T., Kulebyakian, V. et al. Structure and mechanical properties of crystals of partially stabilized zirconia after thermal treatment //PHYSICS OF THE SOLID STATE. 2013. V. 5 . N8. P. 690.